

Параметри виготовлення зразків

Зразок	Розчин, %	ω , об/хв	t_d , хв	УЗ	Площа, мм ²	Примітка
d41	3-4	3000	20	ні	31	
d42	3-4	3000	20	так	33	
d43s	3-4	5000	20	ні	23	З одного блоку
d43b					28	
d44s	3-4	5000	20	так	11	З одного блоку
d44b					31	

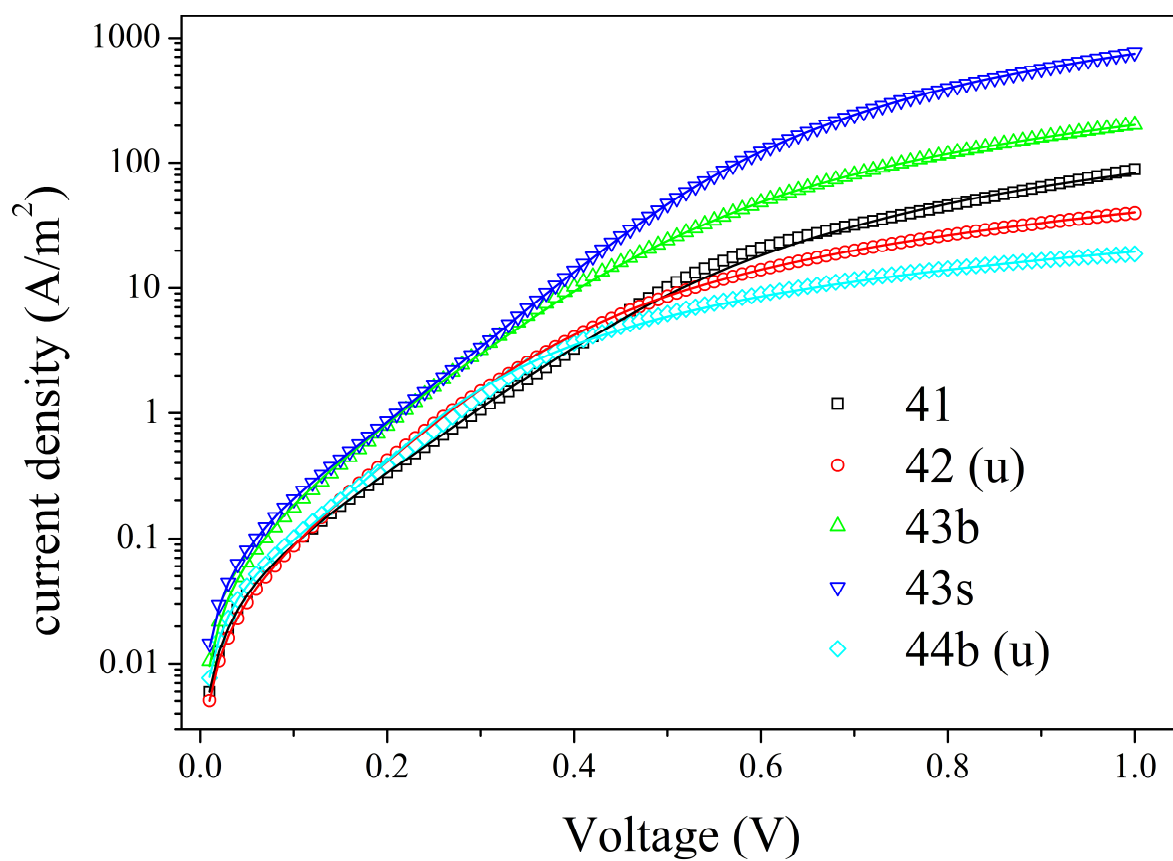
Висота бар'єру по CV-характеристикам

Зразок	Висота бар'єру, еВ		
	1 МГц	100 кГц	10 кГц
d41	0,91	0,71	0,63
d42	1,50	1,0	0,63
d43s	0,69	0,66	0,63
d43b	0,86	0,69	0,65
d44s	1,20	0,89	0,63
d44b	2,0	1,45	0,6

Прямі вольт-амперні характеристики, виміряні при $T=297$ К, апроксимувалися відповідно до одно-діодної моделі:

$$J = J_0 \left\{ \exp \left[\frac{q(V - JR_s)}{nkT} \right] - 1 \right\} + \frac{V - JR_s}{R_{sh}}$$

Зразок	J_0 , А/м ²	n	R_s , Ом м ²	R_{sh} , Ом м ²
d41	0.024	3.05	4.4e-3	3.45
d42 (u)	0.020	2.52	0.013	6.2
d43s	0.039	2.64	4.5e-4	1.3
d43b	0.07	3.05	1.9e-3	велике
d44b (u)	0.0026	1.55	0.033	1.4



Зворотні ВАХ:

